









	<h2 style="color: red;">FQD9N25TF</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD9N25TF
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK
Image may be representation. See specs for product details.	Datenblätter:	1.FQD9N25TF.pdf 2.FQD9N25TF.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQD9N25TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	420 mOhm @ 3.7A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 55W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 7.4A (Tc) 2.5W (Ta), 55W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.4A (Tc)

FQD9N25TF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD9N25TF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD9N25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQD9N25TF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>FQD9N25TM-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>	 <p>FQD9N08TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7.4A DPAK</p>	 <p>FQD9N25TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>	 <p>FQD9N25 FAIRCHI FQD9N25 FAIRCHI</p>
 <p>FQD9N25TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>	 <p>FQD9N25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>	 <p>FQD9N08TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7.4A DPAK</p>	 <p>FQD9N25TM-F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD9N25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD9N25TF Datenblatt	FQD9N25TF-Datenblätter	FQD9N25TF PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD9N25TF
FQD9N25TF Electronic	FQD9N25TF-Komponenten	FQD9N25TF-Verteiler	FQD9N25TF-Bild	FQD9N25TF-Teil
FQD9N25TF Preis	FQD9N25TF Hersteller	FQD9N25TF Bild	FQD9N25TF Aktie	FQD9N25TF Inventar
FQD9N25TF Neu	FQD9N25TF Original	FQD9N25TF garantiert	FQD9N25TF RFQ	FQD9N25TF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited